

	<p>SI2309CDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2309CDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2309CDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 95933 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2309CDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	95933 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.6A (Tc) 1W (Ta), 1.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	345 mOhm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2309CDS-T1-GE3-ND



SI2309CDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2309CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2309CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2309CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2309CDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.25A SOT23-3</p>	 <p>SI2309CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309DS-T1-GE3 VISHAY SI2309DS-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI2309DS VISHAY SI2309DS VISHAY</p>	 <p>SI2309BDS-T1-E3 V SI2309BDS-T1-E3 V</p>	 <p>SI2309BDS-T1-GE3 VISHAY SI2309BDS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI2309DS-T1 VISHAY SI2309DS-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS	 SI2307CDS-T1-E3
 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307DS	 SI2307DS-T1
 SI2307DS-T1-E3	 SI2307DS-T1-GE3	 SI2307DS-T7-E3	 SI2308BDS	 SI2308BDS-T1-E3
 D SI2308BDS-T1-E3	 SI2308BDS-T1-GE3	 SI2308BDS-T1-GE3	 SI2308DS	 SI2308DS-T1
  SI2308DS-T1-E3	  SI2308DS-T1-E3	  SI2308DS-T1-GE3	 SI2309BDS-T1-E3	  SI2309BDS-T1-GE3
  SI2309CDS-T1-GE3	  SI2309DS	 D SI2309DS-T1	  SI2309DS-T1-E3	  SI2309DS-T1-E3
  SI2309DS-T1-GE3	 D SI2309DS-T1-E3	  SI2309DS/A92T	  SI2310DS	  SI2310DS-T1-E3
  SI2310DS-T1-GE3	  SI2311DS	  SI2311DS-T1	  SI2311DS-T1-E3	  SI2311DS-T1-E3
  SI2311DS-T1-GE3	  SI2311DS-T1-GE3	  SI2312BDS	 D SI2312BDS-T1-E3	  SI2312BDS-T1-E3
  SI2312BDS-T1-GE3	  SI2312BDS-T1-GE3	  SI2312CDS-T1-E3	  SI2312CDS-T1-GE3	  SI2312CDS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

